04;07;12

Возможность квазинепрерывного измерения эволюции электронной температуры плазмы с помощью метода томсоновского рассеяния

© М.Ю. Кантор

Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН, С.-Петербург

Поступило в Редакцию 22 мая 1997 г.

Предлагается способ повышения частоты измерений электронной температуры плазмы методом томсоновского рассения вплоть до ста килогерц. В стационарных условиях разряда подход позволяет на три порядка поднять чувствительность диагностики. Приведено экспериментальное подтверждение возможностей метода.

1. Введение

В исследованиях плазмы существует потребность в многократных измерениях электронной температуры с высокой частотой повторения. Она возникает при изучении быстрых переходных процессов в плазме крупных токамаков (например, *L*-*H* переход, внутренний срыв), в измерениях на плазменных установках с малым временем разряда, а также в ряде диагностических методик. Главное препятствие в выполнении таких измерений с помощью метода томсоновского рассеяния — отсутствие подходящих многоимпульсных зондирующих лазеров. Развитие томсоновской диагностики в этом направлении может быть связано с режимом свободной генерации лазера, который отличается высокой частотой повторения лазерных импульсов. По сравнению с режимом модулированной добротности в нем также значительно увеличивается энергия излучения за счет снижения потерь в резонаторе и повышения допустимой плотности энергии излучения за счет снижения потерь в резонаторе и повышения допустимой плотности энергии излучения на оптических элементах.

34

Режим свободной генерации зондирующего лазера

Возможность реализации этих преимуществ в томсоновском рассеянии открывается лазерным внутрирезонаторным и многопроходным зондированием плазмы [1,2]. На рис. 1 изображена оптическая схема предлагаемой системы. Активный элемент (3) помещен в резонатор, образованный глухим зеркалом (1) и многопроходной системой, состоящей из двух вогнутных зеркал (5, 6) и фокусирующей линзы (4). Между зеркалами многопроходной системы расположена камера токамака (7). Объектив (2), составленный из положительной и отрицательной линз, служит для уменьшения расходимости лазерного пучка.

Излучения лазера в свободной генерации имеет хаотический характер. Однако, средняя интенсивность излучения I и частота следования импульсов ν определяются накачкой, свойствами резонатора и активного элемента (см., например, [3]). Плотность энергии излучения в импульсе находится как $\omega_P = I/\nu$. Эти величины хорошо воспроизводятся от выстрела к выстрелу. Для трехуровнего лазера они равны:

$$I = (\omega_S/\tau_S)^* (P-1)^* \alpha/\gamma, \quad \nu = (\alpha(P-1)/2\tau_S\tau_R)^{1/2}/\pi,$$

$$\omega_P = (\pi\omega_S/\gamma)^* (2\tau_R(P-1)\alpha/\tau_S)^{1/2}, \quad \alpha = \sigma N_{\rm Cr} l. \tag{1}$$

. ...

1 10

Здесь ω_S — плотность энергии насыщения рубина, τ_S — время жизни верхнего лазерного уровня, P — превышение мощности накачки над порогом, $N_{\rm Cr}$ — концентрация ионов Cr в кристалле, l — длина активного элемента, γ — полные логарифмические потери излучения в резонаторе, τ_R — время двойного прохода в резонаторе. Для четырехуровнего лазера аналогичные величины принимают вид:

$$I = (\omega_S/\tau_S)^* (P-1); \quad \nu = (\gamma(P-1)/2\tau_S\tau_R)^{1/2}/\pi;$$
$$\omega_P = \pi\omega_S (2\tau_R(P-1)/\tau_S\gamma)^{1/2}. \tag{2}$$

Интенсивность излучения в отдельном импульсе свободной генерации от 3 до 10 раз превышает средний уровень. После выхода из активного элемента оно усиливается в много проходной системе. Если логарифмические потери при N проходах луча между зеркалами (5) и (6) равны γ_{MPS} , то усиление излучения составит

$$N_{\text{eff}} = \left(1 - \exp(-\gamma_{MPS})\right) / \left(1 - \exp(-\gamma_{MPS}/N)\right). \tag{3}$$



Рис. 1. Оптическая схема лазерного зондирования. *1* — 100% зеркало, 2 — корректирующий объектив, 3 — активный элемент, 4 — фокусирующая линза, *5, 6* — зеркала многопроходной системы, 7 — плазма.

Оценим параметры излучения в этой системе для типичного рубинового лазера с $\alpha = 10$, P = 4, длительностью генерации 2 мс и апертурой активного элемента 2 см². При 30 проходах луча и $\gamma = 0.5$ усиление излучения $N_{\rm eff} = 24$. При расстоянии между зеркалами равным 2 м, величина τ_R составит около 200 нс. В этом случае средняя мощность зондирования будет 2.8 МВт: частота следования импульсов 50 кГц и энергия в импульсе 58 Дж. Такие параметры излучения делают возможным использования режима свободной генерации в томсоновской диагностике плазмы.

3. Экспериментальные результаты

Проверка метода проводилась с помощью системы зондирования, состоящей из рубинового стержня длиной 240 мм и многопроходной системы из двух зеркал радиусом кривизны 1000 мм и диаметром 120 мм [2]. Поверхности всех оптических элементов, кроме торцов рубина, были просветлены. Из-за отсутствия информации о лучевой стойкости данного кристалла в режиме свободной генерации интенсивность излучения в активном элементе была ограничена на заведомо безопасном уровне 1 МВт / см². Для элементов высокого качества такое ограничение может быть снято.

Потери излучения в резонаторе составляли 33% без учета рассеяния излучения в рубине и потерь в многопроходной системе. Последние весьма существенно сказываются на эффективности зондирования. По-



Рис. 2. Генерация лазера при низких потерях излучения в многопроходной системе. *а* — общий вид, *b* — характерные импульсы *U*_{НАК} = 3.6 кВ.

этому в работе изучалась генерация в случае малых и повышенных потерь в многопроходной системе. В первом случае поглощалось менее 1% излучения за один проход между зеркалами, что обеспечивало возврат в активный элемент до 80% излучения при 30 проходах луча и усиление энергии зондирования в 25 раз ($N_{\rm eff} = 25$) [2]. При 4% потерях после 24 проходов из многопроходной системы возвращалось третья часть излучения и $N_{\rm eff}$ было равно 15.

На рис. 2 и 3 показана лазерная генерация в этих случаях. Ее параметры хорошо согласуются с оценками (1). Частота следования импульсов в обоих случаях близка к 30 кГц. В первом случае энергия зондирования в импульсе составляет около 50 Дж, во втором она снижается до 25 Дж. Полная энергия зондирования составляла соответственно 3200 и 1500 Дж. В случае высоких потерь излучения уровень накачки потребовалось повысить на 80%.

Несмотря на то, что система зондирования не была в достаточной степени оптимизирована для режима свободной генерации в экспериментах получены высокие параметры зондирующего излучения. Экс-



Рис. 3. Генерация лазера при высоких потерях излучения в многопроходной системе. *а* — общий вид, *b* — характерные импульсы U_{HAK} = 4.8 кВ.

траполяция экспериментальной зависимости параметров генерации от энергии накачки показывает, что снятие ограниченаия на интенсивность пучка увеличивает энергию зондирования до 7 кДж и частоту генерации импульсов до 50 кГц. При оптимизации системы возможно повышение энергии в отдельном импульсе до 100 Дж и частоты до 100 кГц. Для широкого круга задач физики плазмы это означает возможность квазинепрерывных измерений электронной температуры.

Погрешность измерения электронной температуры

Как видно, энергия зондирования в отдельном лазерном импульсе на порядок больше, чем в традиционных системах томсоновской диагностики. Однако, мощность зондирования оказывается на порядок ниже типичных значений. Поэтому она, наряду с фотодетекторами, используемыми для регистрации рассеяного света, определяет в значительной мере погрешность измерений температуры.

При зондировании плазмы рубиновым лазером используются фотоумножители. В этом случае погрешность измерения температуры зависит главным образом от среднего числа фотонов N_S , собранных в спектральном канале, квантовым выходом ФЭУ η и отношением Kфонового свечения плазмы к потоку рассеянного излучения:

$$\delta T/T \sim \left(\left(1 + 2K/\eta N_s \right)^{1/2}.$$
(4)

В этой области спектра при 10 МВт мощности зондирования свечение плазмы будет одного порядка с расеянным излучением. Если пропускание системы сбора излучения составляет 25%, то при концентрации $3 \cdot 10^{13}$ см⁻³, из плазменного объема размером 1 см в телесном угле 0.003 стер от лазерного импульса с энергией 50 Дж в спектре рассеяния соберется $3 \cdot 10^5$ фотонов. Модельные расчеты показывают, что при использовании ФЭУ с фотокатодом S20, квантовый выход которого меняется от 3 до 10% в диапазоне от 700 до 600 нм, погрешность измерения температуры будет 5% при уровне фонового излучения плазмы K = 1. С изменением свечения плазмы погрешность измерений меняется согласно (4), оставаясь на 10% уровне даже при десятикратном превышении фона над сигналом рассеяния.

При зондировании плазмы с помощью лазера на стекле, активированном неодимом, для регистрации рассеянного излучения используются лавинные фотодиоды, имеющие высокий квантовый выход в инфракрасной области спектра. В отличие от ФЭУ они обладают заметным вунтренним шумом порядка 10^{-13} Вт/(Гц)^{1/2}. При регистрации микросекундных сигналов рассеяния в полосе частот несколько мегагерц их чувствительность находится на уровне нескольких тысяч фотонов в микросекунду. Это ограничивает применение неодимового лазера при низкой плотности плазмы, несмотря на слабый уровень ее свечения в инфракрасной области. При высокой плотности этот лазер будет обладать определенными преимуществами, благодаря значительно более эффективному преобразованию энергии накачки в излучение.

Предлагаемая система открывает новые возможности для метода томсоновского рассеяния. Прежде всего это — детальное изучение быстрых переходных процессов в плазме. В стационарных условиях разряда, при накопении сигналов рассеяния за время свободной генерации лазера, новая система примено на три порядка величины повышает чувствительность диагностики. С применением периодической импульсной

накачки лазера эти возможности дополняются измерениями эволюции электронной температуры плазмы на большем временном масштабе с частотой десятки герц.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 97-02-18084.

Список литературы

- [1] Kantor M.Yu., Kouprienko D.V. et al. 23rd EPS Conf. on Contr. Fusion and Plasma Physics, Kiev. 1996. v. III. p. 1100.
- [2] Кантор М.Ю., Куприенко Д.В. // Письма в ЖТФ. 1997. т. 23. В. 8. С. 65.
- [3] О. Звелто. Физика лазеров, М.: Мир, 1979.